

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК ДВУХБАРЬЕРНЫХ НАНОСТРУКТУР

*B. F. Елесин**

*Московский государственный инженерно-физический институт
115409, Москва, Россия*

Поступила в редакцию 13 декабря 2001 г.

В рамках последовательной квантовомеханической модели аналитически вычислен высокочастотный линейный отклик для резонансно-туннельного диода с несимметричными барьерами. Показано, что ток отклика исключительно чувствителен к асимметрии барьера. Так, если «мощность» барьера коллектора α_1 становится меньше «мощности» эмиттера α_2 (например, из-за напряжения смещения), ток меняет знак при некоторой частоте, зависящей от параметров структуры. В обратной ситуации ($\alpha_1 \geq \alpha_2$) ток сохраняет знак во всем интервале частот. Таким образом, появляется принципиальная возможность согласовать полученные ранее экспериментальные и теоретические результаты. В то же время квантовый режим высокочастотной генерации резонансно-туннельного диода, предсказанный ранее для $\alpha_1 = \alpha_2$, реализуется для любых α_1 и α_2 . В этом режиме возможно достижение больших мощностей на частотах, значительно превышающих ширину резонансного уровня. В работе также показано, что механизм когерентного усиления в резонансно-туннельных диодах тесно связан с квантовой интерференцией резонансно-туннелирующих электронов и существенно отличается от обычно предполагаемого.

PACS: 73.20.Dx, 72.30.+q, 72.10.-d

1. ВВЕДЕНИЕ

Высокочастотные свойства двухбарьерных наноструктур, в частности резонансно-туннельного диода, остаются нерешенной теоретической проблемой. Общепринятая теория высокочастотного отклика и генерации в резонансно-туннельном диоде в настоящее время отсутствует, несмотря на интенсивные исследования и несомненный практический интерес. Более того, опубликованные работы содержат противоречивые результаты по частотной зависимости отклика даже в линейном по полю приближении.

Так, в теоретических работах [1–3] (численные методы), [4] (аналитическая модель), [5, 6] (метод туннельного гамильтонiana) утверждается, что ток поляризации (линейный отклик), описывающий усиление в резонансно-туннельном диоде, может изменять знак при некоторой частоте, примерно равной ширине резонансного уровня Г. Имеются и экспериментальные данные о смене знака [7]. Отсюда делается вывод о существовании предельной частоты

усиления и генерации резонансно-туннельного диода. Такая точка зрения достаточно широко распространена (см., например, [8]).

С другой стороны, экспериментально достигнутая частота генерации 10^{12} с^{-1} в [9] и теоретические результаты [10–14] свидетельствуют об обратном. Действительно, в [10–14] (см. также [15]) аналитически и численно показано, что ток остается значкопостоянным в широком интервале частот.

Оставляя пока работы [1–3], выполненные численными методами (см. ниже в Заключении и в [10]), укажем, что в упомянутых работах либо используется метод туннельного гамильтонiana, либо уравнение Шредингера не решается явно. Вместе с тем система когерентных туннелирующих в резонансно-туннельный диод электронов, взаимодействующих с электромагнитным полем, требует последовательного квантовомеханического описания и открытых граничных условий. Это связано с явлением квантовой интерференции электронов, весьма чувствительной к энергии подводимых из коллектора электронов и к граничным условиям. Нам представляется, что применяемые в [4–6] подходы не

*E-mail: VEF@supercon.mephi.ru

удовлетворяют перечисленным требованиям. Напротив, использованная в работах [10–14] модель является достаточно строгой.

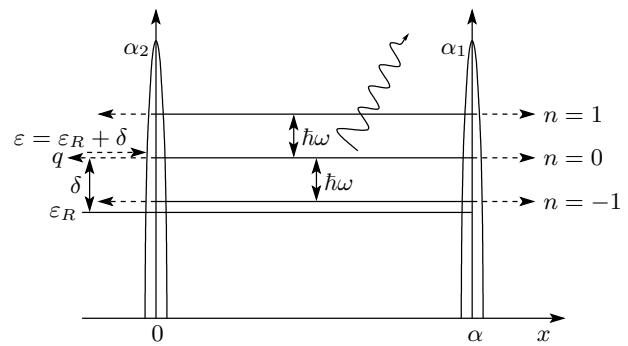
Однако в [10–14] предполагалась полная симметрия барьеров. Как оказывается, асимметрия барьеров эмиттера и коллектора (всегда наблюдающаяся экспериментально и, видимо, в численных расчетах [1–3] из-за поля смещения) может радикально изменить частотную зависимость.

Цель настоящей работы — обобщить результаты [10] на более общие граничные условия, чтобы попытаться согласованно объяснить известные теоретические и экспериментальные результаты. В работе в рамках модели [10] найдено точное аналитическое решение и простые выражения для токов поляризации. Показано, что отклик исключительно чувствителен к разнице параметров барьеров. Так, если «мощность» барьера коллектора α_1 становится меньше мощности барьера эмиттера α_2 (т. е. $\alpha_1 < \alpha_2$), ток изменяет знак при некоторой частоте, зависящей от параметров барьеров. В обратной ситуации ($\alpha_1 \geq \alpha_2$) ток сохраняет знак во всем интервале частот. Таким образом, появляется, по крайней мере, принципиальная возможность согласовать экспериментальные [7, 8] и теоретические численные [1–3, 11–13] и аналитические результаты [10]. Отметим, что согласно [4–6] отклик проявляет слабую зависимость от разности $\alpha_2 - \alpha_1$, еще раз демонстрируя неприменимость подходов, используемых для описания когерентной генерации (см. подробнее в Заключении).

В работе также показано, что механизм усиления в резонансно-туннельном диоде тесно связан с квантовой интерференцией и существенно отличается от обычно предполагаемого.

2. ВОЛНОВЫЕ ФУНКИИ РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНОГО ДИОДА В ЛИНЕЙНОМ ПО ПОЛЮ ПРИБЛИЖЕНИИ

Мы изучим модель когерентного туннелирования в резонансно-туннельном диоде, аналогичную [10]. Рассматривается одномерная квантовая яма с δ -функциональными барьерами в точках $x = 0$ и $x = a$ (см. рисунок). Слева ($x \rightarrow -\infty$) к квантовой яме подводится стационарный поток электронов, пропорциональный q^2 , с энергией ε , приблизительно равной энергии резонансного уровня ε_R . В области квантовой ямы действует



переменное электрическое поле $E(t)$ с потенциалом $U(x, t)$:

$$U(x, t) = U(x) \cos \omega t,$$

$$U(x) = \begin{cases} xU\theta(x), & x < a, \\ aU & x > a, \\ U = -eE/2. & \end{cases} \quad (1)$$

Волновая функция $\Psi(x, t)$ удовлетворяет уравнению Шредингера

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + [\alpha_2 \delta(x) + \alpha_1 \delta(x-a)] \Psi + U(x, t) \Psi. \quad (2)$$

Здесь положено $\hbar = 2m = 1$. Установившееся решение (2) ищем в виде [2, 10, 16]

$$\Psi(x, t) = e^{-i\varepsilon t} [\psi_0(x) + e^{-i\omega t} \psi_{+1}(x) + e^{i\omega t} \psi_{-1}(x)]. \quad (3)$$

Парциальные волновые функции ψ_0 , ψ_n ($n = \pm 1$) описывают электроны с квазиэнергиями соответственно ε и $\varepsilon + n\omega$.

Переменное поле вызывает токи поляризации (отклика)

$$J^c(x, t) = J^c(x) \cos \omega t, \quad J^s(x, t) = J^s(x) \sin \omega t.$$

Здесь J^c — синфазный с полем и J^s — реактивный токи; J^c и J^s можно выразить через функции ψ_0 и ψ_n :

$$\begin{aligned} J^c(x) &= J^c_{+1}(x) + J^c_{-1}(x), \\ J^c_n(x) &= -ie [(\psi_0^* \psi'_n + \psi_n^* \psi'_0) - \text{с.с.}], \\ J^s(x) &= J^s_{+1}(x) - J^s_{-1}(x), \\ J^s_n(x) &= e [(\psi_0^* \psi'_n - \psi_n^* \psi'_0) + \text{с.с.}], \quad \psi' \equiv \frac{d\psi}{dx}. \end{aligned} \quad (4)$$

Функция нулевого приближения $\psi_0(x)$ в области $0 < x < a$ удовлетворяет уравнению

$$\varepsilon \psi_0(x) + \psi''_0(x) = 0 \quad (5)$$

и граничным условиям (см. [8])

$$\begin{aligned}\psi_0(0)(1 - \beta_2) + \psi'_0(0)/ip &= q, & p^2 &= \varepsilon, \\ \psi_0(a)(1 - \beta_1) - \psi'_0(a)/ip &= 0, \\ \beta_j = \alpha_j/ip, & j = 1, 2.\end{aligned}\quad (6)$$

Соответствующие уравнения и граничные условия для функций $\psi_n(x)$ в линейном по полю приближении имеют вид

$$p_n^2 \psi_n(x) + \psi''_n(x) = U(x) \psi_0(x), \quad p_n^2 = p^2 + n\omega, \quad (7)$$

$$\begin{aligned}\psi_n(0)(1 - \beta_{2n}) + \frac{\psi'_n(0)}{ip} &= 0, \\ \psi_n(a)(1 - \beta_{1n}) - \frac{\psi'_n(a)}{ip_n} &= \frac{aU\psi_0(a)}{2p_n^2}, \\ \beta_{jn} = \frac{\alpha_j}{ip_n}, & j = 1, 2.\end{aligned}\quad (8)$$

В (5)–(8) предполагается, что $\psi_n \ll \psi_0$. Решение системы (5)–(8) можно представить в следующей форме:

$$\begin{aligned}\psi_0(x) &= A \exp(ipx) + B \exp(-ipx) \equiv \\ &\equiv \gamma_0 \cos px + i\delta_0 \sin px, \\ A\Delta_0 &= q(2 - \beta_1) \exp(-2ipa), \quad B\Delta_0 = q\beta_1,\end{aligned}\quad (9)$$

$$\begin{aligned}\Delta_0 &= (2 - \beta_1)(2 - \beta_2) \exp(-2ipa) - \beta_1\beta_2 \approx \\ &\approx \frac{2}{\sqrt{\Gamma_1\Gamma_2}} (i\delta - \Gamma),\end{aligned}\quad (10)$$

$$\delta = \varepsilon - \varepsilon_R, \quad \Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2, \quad \Gamma_j = \frac{2p^3}{a\alpha_j^2},$$

$$\begin{aligned}\psi_n &= A_n \exp(ip_n x) + B_n \exp(-ip_n x) - \\ &- \frac{xU}{\omega_n} \psi_0 - \frac{2U}{\omega_n^2} \psi'_0,\end{aligned}\quad (11)$$

$$\begin{aligned}A_n\Delta_n &= q_n(2 - \beta_{1n}) \exp(-2ip_n a) + \beta_{2n}\tilde{q}_n, \\ B_n\Delta_n &= q_n\beta_{1n} + (2 - \beta_{2n})\tilde{q}_n, \quad \omega_n = -n\omega, \\ \Delta_n &\approx \frac{2}{\sqrt{\Gamma_1\Gamma_2}} [i(\delta + n\omega) - \Gamma],\end{aligned}\quad (12)$$

$$q_n = \frac{2Uip}{\omega_n^2} \left[A(2 - \beta_{2n}) + \beta_{2n}B + \frac{\omega_n^2}{4p^4}(A + B) \right], \quad (13)$$

$$\begin{aligned}\tilde{q}_n &= -\frac{2Uip}{\omega_n^2} \left[\beta_{1n}A + (2 - \beta_{1n})Be^{-2ip_n a} + \right. \\ &\left. + \frac{\omega_n^2}{4p^4}(A + Be^{-2ipa}) \right] e^{i(p-p_n)a}.\end{aligned}$$

Формулы (9)–(13) дают точное решение задачи, которое, к сожалению, громоздко и необозримо. Однако, как показано в [10], существует возможность преобразовать общие формулы для ψ_n и токов J^c, J^s к простым и физически наглядным выражениям, используя естественный для резонансно-туннельного диода малый параметр ω/ε_R . Действительно, малость частоты ω по сравнению с энергией ε_R приводит генератору на резонансно-туннельном диоде.

Чтобы провести это преобразование, представим величины $\gamma_n = A_n + B_n$ и $\delta_n = A_n - B_n$ в виде суммы слагаемых

$$\begin{aligned}\gamma_n &= \gamma_n^{(1)} + \gamma_n^{(2)} + \gamma_n^{(3)}, \\ \delta_n &= \delta_n^{(1)} + \delta_n^{(2)} + \delta_n^{(3)}.\end{aligned}\quad (14)$$

В слагаемых $\gamma_n^{(1)}$ и $\delta_n^{(1)}$ полагаем $p = p_n$ в показателях экспонент, а в $\gamma_n^{(2,3)}$ и $\delta_n^{(2,3)}$ формируем разность между точными и выделенными выражениями. После компенсации в $\gamma_n^{(1)}$ и $\delta_n^{(1)}$ ряда членов и сокращения определителя в знаменателе получаем

$$\gamma_n^{(1)} = \frac{2Uip}{\omega_n^2} \delta_0, \quad \delta_n^{(1)} = \frac{2Uip}{\omega_n^2} \gamma_0. \quad (15)$$

Отметим, что $\gamma_n^{(1)}$ и $\delta_n^{(1)}$ расходятся при $\omega \rightarrow 0$. Оставшиеся слагаемые оказываются конечными в низкочастотном пределе и равными

$$\gamma_n^{(2)} = -\frac{4Uip}{\omega_n^2 \Delta_n} [\beta_{1n}A z_n + (2 - \beta_{1n})B e^{-2ip_n a} z_n^*], \quad (16)$$

$$\delta_n^{(2)} = \gamma_n^{(2)} (\beta_{2n} - 1), \quad z_n = \exp(ipa - ip_n a) - 1. \quad (17)$$

В (16), (17) опущены малые члены порядка ω/ε_R и Γ/ε_R . Здесь мы рассматриваем наиболее интересный случай квантовой ямы с «сильными» барьерами, когда $\Gamma/\varepsilon_R \ll 1$ и $p/\alpha_j \ll 1$. Именно в этом пределе реализуются замечательные свойства квантовых ям. С учетом малости ω/ε_R и Γ/ε_R (16) окончательно приводится к виду

$$\gamma_n^{(2)} = -\frac{4Ua^2\alpha_1 A}{p^2 \Delta_n}. \quad (18)$$

Видно, что выражение $\gamma_n^{(2)}$ и, согласно (17), $\delta_n^{(2)}$ конечны при $\omega \rightarrow 0$.

Разбиение γ_n и δ_n (а следовательно, и A_n и B_n) позволяет записать волновую функцию $\psi_n(x)$ в более простой форме:

$$\psi_n = \gamma_n^{(2)} \cos p_n x + i\delta_n^{(2)} \sin p_n x. \quad (19)$$

Действительно, можно показать, что расходящиеся при $\omega \rightarrow 0$ выражения в $\psi_n(x)$ взаимно компенсируются. Таким образом, волновые функции $\psi_n(x)$

конечны в низкочастотном пределе и на границах ямы принимают значения

$$\psi_n(0) = \psi_n(a) = \gamma_n^{(2)}. \quad (20)$$

Следует отметить, что в упомянутых выше работах [4–6] функция $\psi_n(x)$ расходится при $\omega \rightarrow 0$. В то же время нетрудно убедиться непосредственно (полагая $\omega = 0$ в (1) с самого начала), что функция ψ_n не должна иметь особенностей при $\omega = 0$. Не исключено, что это обстоятельство и является причиной расхождения частотных зависимостей токов поляризации.

Пользуясь выражениями (9) и (20), найдем критерий линейного приближения при $\omega \ll \Gamma$: $Ua/\Gamma \ll 1$. Он резко отличается от соответствующего критерия в [4–6]: $Ua/\omega \ll 1$. Разница связана с поведением $\psi_n(x)$ при $\omega \rightarrow 0$.

3. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК В РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНОМ ДИОДЕ

Вначале найдем активную составляющую тока J^c . Подставляя ψ_0 из (9) и ψ_n из (19) в (4), получим

$$\begin{aligned} J_n^c(x) &= ep \{ (K_n + \text{c.c.}) \times \\ &\quad \times [\sin p_n x \sin px + \cos p_n x \cos px] - \\ &- i(F_n - \text{c.c.}) [\sin px \cos p_n x - \sin p_n x \cos px] \} \equiv \\ &\equiv ep \{ (K_n + \text{c.c.}) \cos(p - p_n)x - \\ &- i(F_n - \text{c.c.}) \sin(p - p_n)x \}, \end{aligned} \quad (21)$$

$$K_n = \delta_0^* \gamma_n^{(2)} + \gamma_0^* \delta_n^{(2)}, \quad F_n = \delta_0^* \delta_n^{(2)} + \gamma_0^* \gamma_n^{(2)}. \quad (22)$$

Вклад в ток $J_n^c(x)$ вносят слагаемые четырех типов: переходы под действием поля между состояниями с волновыми функциями $\sin px$ и $\sin p_n x$ с весом $\delta_0^* \delta_n^{(2)}$, между $\cos px$ и $\cos p_n x$ с весом $\gamma_0^* \gamma_n^{(2)}$, между $\sin px$ и $\cos p_n x$ с весом $\delta_0^* \gamma_n^{(2)}$ и, наконец, между $\cos px$ и $\sin p_n x$ с весом $\gamma_0^* \delta_n^{(2)}$. Следует иметь в виду, что слагаемое в токе, пропорциональное, например, $\sin px \cos p_n x$, появляется в результате перехода между состояниями $\sin px$ и $\sin p_n x$, так как $J_n^c \propto (\psi^* \psi' - \text{c.c.})$. Это слагаемое соответствует переходу «лазерного» типа, так как волновые функции $\sin px$ и $\sin p_n x$ совпадают с собственными функциями изолированной квантовой ямы. Правда, в рассматриваемой ситуации импульсы p и p_n различаются на малую величину $\omega_n/2p$. (В лазере $p - p_n = \pm \pi/a$.) Так как коэффициенты $\delta_0 \sim \beta \gamma_0$, $\delta_n^{(2)} \sim \beta \gamma_n^{(2)}$, вклад этого слагаемого по сравнению со вторым $\gamma_0^* \gamma_n^{(2)}$ (между $\cos px$ и $\cos p_n x$) велик по параметру $\alpha^2/p^2 \gg 1$.

Слагаемые между «смешанными» состояниями (характерными для токового состояния в резонансно-туннельном диоде и исчезающими в изолированной яме) $\sin p_n x$ и $\cos px$, $\sin px$ и $\cos p_n x$ входят с примерно одинаковыми весами $\delta_0^* \gamma_n^{(2)}$ и $\gamma_0^* \delta_n^{(2)}$, что позволяет им эффективно интерферировать. Именно эти переходы приводят к необычной частотной зависимости $J_n^c(x)$, а также к исключительной чувствительности тока от разности «мощности» барьеров $\alpha_2 - \alpha_1$ эмиттера (α_2) и коллектора (α_1) резонансно-туннельного диода.

Подставляя (18) в (22), получаем выражение для K_n :

$$K_n = \frac{q}{\Delta_0^*} \gamma_n^{(2)} \varphi, \quad \frac{\varphi}{\Delta_0^*} = \beta_{2n}(A^* + B^*) - 2B^*, \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \beta_2(2 + \beta_1) \exp(2ipa) - \beta_1 \beta_2 + 2\beta_1 = \\ &= \Delta_0^* - 2\Delta_{01}^* \exp(ipa), \end{aligned} \quad (24)$$

снова пренебрегая членами порядка ω/ε_R . Здесь Δ_0 дается выражением (10), а Δ_{01} — «урезанный определитель»:

$$\Delta_{01} = (2 - \beta_1) \exp(-ipa) + \beta_1 \exp(ipa). \quad (25)$$

Функция φ из (24) описывает суперпозицию упомянутых выше переходов «нелазерного» типа и сильно зависит от разностей $\delta = \varepsilon - \varepsilon_R$ и $\alpha_2 - \alpha_1$. Здесь ε_R — энергия резонансного уровня, определяемая из уравнения

$$\operatorname{Re} \Delta_0(\varepsilon_R) = 0. \quad (26)$$

Вблизи резонанса и при условии $\Gamma/\varepsilon_R \ll 1$ функцию φ можно представить в виде

$$\varphi = -\frac{i\alpha_1 \alpha_2 a \delta}{p^3} + 2 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right). \quad (27)$$

При $\alpha_2 = \alpha_1 = \alpha$ формула (23) переходит в соответствующее выражение для K_n , полученное в [10].

Вначале рассмотрим ситуацию при $\alpha_2 = \alpha_1$. Из (27) видно, что в резонансе, когда $\varepsilon = \varepsilon_R$, имеем $\varphi = 0$. Это означает, что вклады в ток J_n^c при $\cos(p - p_n)x$ (практически не зависящие от координаты и являющиеся основными при $\omega \ll \Gamma$) равны нулю в отдельности, как J_{+1}^c , так и J_{-1}^c . Если $\delta \neq 0$, оба тока J_{+1}^c и J_{-1}^c отличны от нуля и имеют одинаковый знак. Мы увидим, что это соответствует излучению при $\delta > 0$ и поглощению при $\delta < 0$. Обычно же предполагается, что J_{+1}^c приводит к поглощению, J_{-1}^c — к излучению [4–6, 8], а результатирующий знак отклика определяется их разницей. Это, кстати, позволяет получать в [4–6] при $\omega \rightarrow 0$ конечные выражения для тока, хотя волновые функции расходятся (см. разд. 2).

Согласно же (23), (27) и (18) знаки низкочастотных вкладов в J_n^c одинаковы и определяются интерференцией переходов «нелазерного» типа, зависящей от условий резонанса (т. е. от δ).

Теперь рассмотрим влияние границ. Как следует из (27), отличие α_1 от α_2 ведет к появлению мнимой добавки к δ , зависящей от разности $\alpha_1/\alpha_2 - \alpha_2/\alpha_1$:

$$\varphi = -\frac{2i}{\sqrt{\Gamma_1 \Gamma_2}} \left[\delta + i\sqrt{\Gamma_1 \Gamma_2} \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right) \right]. \quad (28)$$

Подставляя значения для $\gamma_n^{(2)}$ из (18) и φ в (22), приходим к следующему выражению для $K_n + \text{с.с.}$:

$$K_n + \text{с.с.} = -\frac{4Ua}{|\Delta_0|^2 \Gamma_1^{3/2} \Gamma_2^{1/2}} \left[\delta \left(\frac{1}{\Delta_n} + \frac{1}{\Delta_n^*} \right) + \right]$$

$$+ i(\Gamma_1 \Gamma_2)^{1/2} \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right) \left(\frac{1}{\Delta_n} - \frac{1}{\Delta_n^*} \right) \right]. \quad (29)$$

Аналогичным путем найдем выражение для «лазерноподобных» переходов

$$F_n - \text{с.с.} = \frac{8iUp}{|\Delta_0|^2 \Gamma_1^{3/2} \Gamma_2^{1/2}} \left(\frac{1}{\Delta_n} - \frac{1}{\Delta_n^*} \right), \quad (30)$$

которое слабо зависит от разницы $\alpha_2 - \alpha_1$. Можно показать, что вклад в J_n^c от $(F_n - \text{с.с.})$ дает поглощение для $n = +1$ и излучение при $n = -1$ в соответствии с обычными представлениями.

Подставляя Δ_n , Δ_0 в (29) и (30) и собирая результаты, получаем окончательные выражения для тока $J^c(x) = J_{+1}^c(x) + J_{-1}^c(x)$ и приведенного тока J^c :

$$J^c(x) = -\frac{e^2 E a Q \Gamma \Gamma_2 \delta}{(\delta^2 + \Gamma^2) [(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2] [(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]} \times \\ \times \left\{ \left[(\delta^2 + \Gamma^2 + \omega^2) - \frac{\alpha_1^2 - \alpha_2^2}{\alpha_1^2 + \alpha_2^2} (\delta^2 + \Gamma^2 - \omega^2) \right] \cos \frac{\omega}{2p} x - \frac{4\omega p}{a} \sin \frac{\omega}{2p} x \right\}, \quad (31)$$

$$J^c = \frac{1}{a} \int_0^a J^c(x) dx = -\frac{e^2 E a Q \Gamma \Gamma_2 \delta \left[(\Gamma^2 + \delta^2) + \frac{\Gamma_1 - \Gamma_2}{\Gamma_1 + \Gamma_2} (\Gamma^2 + \delta^2 - \omega^2) \right]}{(\Gamma^2 + \delta^2) [(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2] [(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]}, \quad Q = pq^2. \quad (32)$$

Вклад «лазерного» слагаемого ($F_n - \text{с.с.}$) в приведенный ток J_n^c , пропорциональный ω^2 , в частности компенсируется соответствующим членом в $(K_n + \text{с.с.})$. Поэтому результирующее выражение (32) имеет интерференционную природу и происходит от $(K_n + \text{с.с.})$.

При одинаковых барьерах $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma/2$ мы приходим к результату, впервые полученному в [10]:

$$J^c = -\frac{e^2 E a Q \Gamma^2 \delta}{2 [(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2] [(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]}, \quad (33)$$

если исправить допущенную там опечатку: в знаменателе (33) должно стоять 2 вместо 4. Нетрудно видеть, что ток $J^c(\delta, \omega)$ не меняет знака во всем интервале частот. В низкочастотном пределе, $\omega \ll \Gamma$, выражается через статическую дифференциальную J^c проводимость:

$$J^c(\delta, 0) = \frac{e^2 E a}{2} \frac{dJ_0(\delta)}{d\delta}, \quad (34)$$

$$J_0(\delta) = \frac{Q \Gamma^2}{2(\delta^2 + \Gamma^2)}, \quad (35)$$

где $J_0(\delta)$ — статический резонансный ток.

Как показано в [10], кроме обычного режима, в котором J^c имеет максимум при $\omega = 0$ (и $\delta < \Gamma$), существует и так называемый «квантовый» режим при $\delta > \Gamma$. Ему соответствует максимум J^c при частоте ω_m :

$$\omega_m^2 = \delta^2 - \Gamma^2, \quad \delta > \Gamma. \quad (36)$$

Излучение (поглощение) происходит благодаря квазирезонансным переходам между состояниями с энергиями ε и ε_R . Отсюда следует, что при одинаковых барьерах ($\alpha_2 = \alpha_1$) генерация возможна на частотах, значительно превышающих Γ , если выбрать энергию электронов (аналог постоянного напряжения смещения) $\varepsilon = \varepsilon_R + \omega$ вне области максимальной отрицательной дифференциальной проводимости (где $\delta < \Gamma$).

Отметим, что описанные выше результаты были подтверждены с высокой точностью численным решением системы (5)–(8), а также непосредственно временного уравнения (2) в работах [12–14].

В случае разных барьеров ($\Gamma_1 \neq \Gamma_2$) частотная зависимость тока J^c может стать кардинально другой. Так, при $\Gamma_1 > \Gamma_2$ ток меняет знак при некотором значении частоты ω_0 :

$$\omega_0^2 = \frac{2\Gamma_1(\delta^2 + \Gamma^2)}{\Gamma_1 - \Gamma_2}. \quad (37)$$

В то же время «квантовый» режим реализуется при любых Γ_1 и Γ_2 . В частности, при $\Gamma_1 \gg \gg \Gamma_2$ максимум тока достигается при частоте $\omega_m^2 = 2(\delta^2 + \Gamma^2) - (\delta^4 + 10\delta^2\Gamma^2 + 9\Gamma^4)^{1/2}$. (Если $\delta \gg \Gamma$, то $\omega_m \approx \delta$.)

При выполнении обратного неравенства, $\Gamma_1 < \Gamma_2$, ток сохраняет знак при любых частотах. В предельном случае $\Gamma_2 \gg \Gamma_1$ частотная зависимость становится необычной для резонансно-туннельного диода:

$$J^c = -\frac{e^2 E a Q \Gamma_2^2 \delta \omega^2}{(\Gamma^2 + \delta^2)[(\delta + \omega)^2 + \Gamma_2^2][(\delta - \omega)^2 + \Gamma_2^2]}. \quad (38)$$

Действительно, при $\omega \rightarrow 0$ ток обращается в нуль и не выражается через дифференциальную проводимость. Остается только квантовый режим, причем максимум $J^c(\delta, \omega)$ достигается для частоты

$$\omega_m^2 = \delta^2 + \Gamma^2 \quad (39)$$

для любого $\delta > 0$.

Найдем также реактивный ток. После некоторых вычислений получаем

$$J_n^s(x) = e p [i(K_n - \text{с.с.}) \cos(p - p_n)x + (F_n + \text{с.с.}) \sin(p - p_n)x] \quad (40)$$

и для приведенного реактивного тока

$$J^s = -\frac{e^2 E a Q \Gamma_2 \delta \omega [\delta^2 - \omega^2 - 3\Gamma^2 + 4(\Gamma_2^2 - \Gamma_1^2)]}{2(\Gamma^2 + \delta^2)[(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2][(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]}. \quad (41)$$

При $\Gamma_1 = \Gamma_2$ эта формула переходит в соответствующее выражение работы [10], если исправить там знак на противоположный.

4. СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДРУГИХ РАБОТ

Как уже обсуждалось детально в [10] и упоминалось выше во Введении, нет единого мнения по вопросу фундаментального ограничения на частоту генерации резонансно-туннельного диода. Согласно довольно широко распространенной точке зрения

(см., например, [4, 8]), частота генерации (т. е. частота, где ток меняет знак и усиление обращается в нуль) ограничена величиной равной Γ .

Это представление основано, в частности, на результатах теоретических работ [1–4], в которых решалось уравнение Шредингера, а также на результатах работ, использующих метод туннельного гамильтонiana [5, 6].

К сожалению, трудно провести непосредственное сравнение с численными расчетами, тем более что среди них много противоречий (см., например, [8, 17]). Как уже указывалось нами выше в разд. 3, возможной причиной изменения знака отклика в [1–3] является несимметричность барьеров из-за напряжения смещения.

Представляется важным провести сравнение с теоретическими результатами, полученными аналитически в наиболее простой постановке, чтобы исключить влияние непринципиальных осложнений. Для этого будем предполагать (как это уже делалось выше), что функция распределения электронов эмиттера имеет δ -образный характер, т. е. электроны предполагаются моноэнергетическими с энергией ε . Затем проведем сравнение и для других функций распределения.

Наиболее близка по постановке задачи работа [4] (см. в ней ссылки на предыдущие работы), где рассмотрена аналитическая модель резонансно-туннельного диода на основе уравнения Шредингера. Но, в отличие от данной работы и [10], автор [4] не находит явного решения уравнения Шредингера в области квантовой ямы. Он записывает волновую функцию на коллекторной границе ($x = a$) в виде

$$\Psi = [t_0 e^{-ipx} + t_{+1} e^{-ip_{+1}x - i\omega t} + t_{-1} e^{-ip_{-1}x - i\omega t}] \times \exp\left(i\varepsilon t - \frac{iV \sin \omega t}{\omega}\right), \quad (42)$$

где t_0 , $t_{\pm 1}$ — амплитуды перехода электронов соответственно через яму без поля и в первом порядке по полю (аналоги наших ψ_0 и $\psi_{\pm 1}$). Структура предполагалась с одинаковыми $\Gamma_1 = \Gamma_2$.

Амплитуды находились суммированием проходящих и отраженных волн (модель резонатора Фабри–Перо) и оказались равными

$$|t_{\pm 1}|^2 = \left(\frac{V}{2\omega}\right)^2 \frac{\Gamma^2 [(\delta \pm \omega/2)^2 + \Gamma^2]}{(\delta^2 + \Gamma^2)[(\delta \pm \omega)^2 + \Gamma^2]}. \quad (43)$$

Они существенно отличаются от наших (см. (18), (20)):

$$|\psi_{\pm 1}(a)|^2 = |\gamma_{\pm}^{(2)}|^2 = \frac{(Va)^2 \Gamma^2}{16(\delta^2 + \Gamma^2)[(\delta \pm \omega)^2 + \Gamma^2]}, \quad (44)$$

вычисленных по точному решению уравнения Шредингера (2) с граничными условиями (6), (8). Принципиальная разница состоит в расходимости $t_{\pm 1}$ при $\omega \rightarrow 0$. Выражение для тока J^c из [4] имеет вид

$$J^c = -\frac{e p V \Gamma^2 \delta (\delta^2 + \Gamma^2 - \omega^2)}{(\Gamma^2 + \delta^2) [(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2] [(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]}. \quad (45)$$

Из (45) следует смена знака при $\omega_0^2 = \delta^2 + \Gamma^2$, наличие предельной частоты и отсутствие квантового режима. Причины расхождения с (33), по-видимому, связаны с приближениями, сделанными в [4] (см. подробнее анализ в [10]). В остальных известных нам аналитических работах, использующих уравнение Шредингера, не приведено замкнутых выражений для токов J^c и J^s .

Большое количество теоретических работ, посвященных вычислению высокочастотного отклика в резонансно-туннельном диоде, использует метод туннельного гамильтониана (см., например, [5, 6] и ссылки там).

Выражение для тока i_2 (аналог J^c), полученное в [5, 6] для δ -образной функции распределения электронов, имеет вид

$$i_2 = -\frac{2e^2 V \Gamma_1 \Gamma_2 \delta (\delta^2 + \Gamma^2 - \omega^2)}{(\Gamma^2 + \delta^2) [(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2] [(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]}. \quad (46)$$

При получении (46) предполагалось, что переменное поле приложено только к эмиттеру. Прежде всего отметим, что отклик i_2 слабо зависит от разности $\Gamma_1 - \Gamma_2$ и при $\Gamma_1 = \Gamma_2$ аналогичен (45) из [4]. Напомним, что в [4] поле предполагалось приложенным ко всей яме.

Чтобы провести сравнение с [5, 6], мы решили уравнение Шредингера (2) с локальным потенциалом

$$U(x, t) = \bar{U} \delta(x) \cos \omega t. \quad (47)$$

Выражение для приведенного тока имеет вид

$$\begin{aligned} J^c &= \\ &= -\frac{8\bar{U}(\Gamma_1 \Gamma_2)^{3/2} \delta / p [\delta^2 + \Gamma^2 + \omega^2 (3\Gamma/2\Gamma_1 - 1)]}{a(\Gamma^2 + \delta^2) [(\delta + \omega)^2 + \Gamma^2] [(\delta - \omega)^2 + \Gamma^2]}. \end{aligned} \quad (48)$$

Видно, что ток, в отличие от (46) и (32), не меняет знака во всем интервале частот и слабо зависит от разности $\Gamma_1 - \Gamma_2$. Кроме того, ток (48) имеет по сравнению с (46) и (32) малость порядка Γ/ε_R . Причина этого очевидна и состоит в следующем. Увеличение функции ψ_n на множитель ε_R/Γ за счет резонанса в яме с полем, приложенным ко всей яме, отсутствует, если поле $U(x, t)$ из (47) локально. Таким образом, в методе туннельного гамильтониана отклик слабо

зависит от вида $U(x, t)$ в отличие от точного результата. Кроме того, отметим, что волновые функции в [5, 6], как и в [4], расходятся при $\omega \rightarrow 0$.

Сравним отклики и для энергетического распределения электронов с квазиравновесной функцией $f(\varepsilon/T)$ (T — температура). В высокотемпературном пределе, когда $\omega, \Gamma \ll T$, получаем для (46) при $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma/2$:

$$i_2 = e^2 \frac{\partial f(\varepsilon_R)}{\partial \varepsilon} \frac{V \Gamma^3 \pi}{4(\omega^2 + \Gamma^2)}. \quad (49)$$

Видно, что усиление ограничивается частотой $\omega \approx \Gamma$. Проводя аналогичное интегрирование для (33), получаем

$$J^c = \frac{e^2 E a Q \Gamma \pi}{4} \frac{\partial f(\varepsilon_R)}{\partial \varepsilon}, \quad (50)$$

т. е. ограничение усиления по частоте отсутствует. По-видимому, указанные противоречия связаны с тем, что явление интерференции и открытые граничные условия некорректно учитываются в методе туннельного гамильтониана. Действительно, в последнем предполагается существование резонансного уровня, и феноменологически вводится перескок между ямой и эмиттером (коллектором). По сути дела, метод туннельного гамильтониана описывает некогерентное туннелирование. В работе [18] дано доказательство этого утверждения, по крайней мере, для $\omega < \Gamma$.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные выражения для токов поляризации для несимметричных барьеров позволяют в принципе согласованно объяснить результаты, полученные экспериментально, а также в результате численного и аналитического решения уравнения Шредингера. Действительно, можно предположить, что в [1–3] и [7] асимметрия барьеров возникла за счет постоянного электрического поля смещения, которое понижает барьер коллектора (т. е. увеличивает Γ_1). Детальное сравнение требует проведения специальных расчетов и экспериментов с контролируемыми Γ_1 и Γ_2 , т. е. с реальными величинами барьеров эмиттера и коллектора. Представляет интерес также проверка усиления в резонансно-туннельном диоде при $\Gamma_2 \gg \Gamma_1$, когда низкочастотное усиление должно стремиться к нулю как ω^2 . Очевидно, что этот результат сохранится при любом виде функции распределения электронов $f(\varepsilon)$. Важно также подчеркнуть, что при любых Γ_1 и Γ_2 квантовый режим генерации сохраняется. Частота, при которой усиление

максимально удовлетворяет условию квазирезонанса $\omega_m \approx \delta$, равна $\omega \gg \Gamma$. Таким образом, как показано в [12, 13], возможно достижение больших мощностей генерации на сверхвысоких частотах.

Подтверждение предсказываемых теорией результатов послужило бы доказательством специфического механизма излучения и поглощения в структурах с когерентным резонансным туннелированием, связанного с чисто квантовым явлением суперпозиции разных типов излучательных переходов.

Что касается метода туннельного гамильтониана, то представляется весьма сомнительным корректность его использования для вычисления высокочастотного отклика в когерентных системах типа резонансно-туннельного диода. Они являются исключительно чувствительными к граничным условиям, истинному виду потенциала переменного поля и корректному описанию явления пространственного квантования. Метод туннельного гамильтониана — по существу, феноменологический, так как резонансный уровень и граничные условия (заменяющиеся перескоком электронов) постулируются.

Автор благодарен Ю. В. Копаеву за полезное обсуждение работы. Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция» и при поддержке Минпромнауки РФ в рамках программы «Физика твердотельных наноструктур».

ЛИТЕРАТУРА

1. W. R. Frensley, Appl. Phys. Lett. **51**, 448 (1987); Rev. Mod. Phys. **62**, 745 (1990).
2. R. K. Mains and G. I. Haddad, J. Appl. Phys. **64**, 3564 (1988); **64**, 504 (1988).
3. C. L. Fernando and W. R. Frensley, Phys. Rev. B **52**, 5092 (1995).
4. H. C. Lju, Phys. Rev. B **43**, 12538 (1991); Erratum **48**, 4977 (1993).
5. M. Büttiker, A. Pretre, and H. Thomas, Phys. Rev. Lett. **70**, 4114 (1993).
6. M. P. Anatram and S. Datta, Phys. Rev. B **51**, 7632 (1995).
7. J. P. Mattia and Mc. Whorter, J. Appl. Phys. **84**, 1140 (1998).
8. H. C. Lju and J. C. L. Sollner, Semicond. Semimet. **41**, 359 (1994).
9. E. R. Brown, J. R. Södestrom, C. D. Parker et al., Appl. Phys. Lett. **58**, 2291 (1991).
10. В. Ф. Елесин, ЖЭТФ **116**, 704 (1999).
11. V. F. Elesin and A. V. Krasheninnikov, Phys. Low-Dim. Struct. **7/8**, 65 (1999).
12. В. Ф. Елесин, И. Ю. Катеев, А. И. Подливаев, ФТП **34**, 1373 (2000).
13. В. Ф. Елесин, И. Ю. Катеев, А. И. Подливаев, УФН **170**(3), 333 (2000).
14. Р. Ф. Казаринов, Р. А. Сурис, ФТП **6**, 148 (1972).
15. N. S. Wingreen, A. P. Janho, and Y. Meir, Phys. Rev. B **48**, 8487 (1993).
16. В. Ф. Елесин, ЖЭТФ **112**, 483 (1997).
17. F. A. Buot and A. R. Rajagopal, Phys. Rev. B **48**, 17217 (1993).
18. V. V. Afonin and A. M. Rudin, Phys. Rev. B **49**, 10466 (1994).